

第四届全国半导体物理学术会议在南京召开

第四届全国半导体物理学术会议于1983年11月27日至30日在南京召开。参加会议的有高等院校、研究所和工厂共66个单位189名代表。

李志坚教授向大会致开幕词。黄昆教授和谢希德教授分别作了题为“聚乙炔半导体”和“半导体物理的某些进展”的特约报告。聚乙炔的研究近几年来在国际上引起了极大的重视。黄昆教授的报告，对这个新课题作了深入浅出的介绍。谢希德教授首先分析了半导体物理的发展趋势，接着又对半导体物理的一些重大进展，特别是半导体表面与界面方面的一些新发展作了概括的介绍。这两个报告受到与会代表的热烈欢迎。

这次会上共有170篇论文进行了交流。会议学术气氛浓厚，代表们思想活跃讨论热烈。自上届会议以来，我国半导体物理工作取得了明显的进展，在研究的深度和广度方面都有所前进。这次会议的一个重要特点是逐渐摆脱了对国外工作的模仿、重复而开始了自己的探索和研究工作。非晶半导体和深能级的研究工作有了明显加强，一些新的课题如二维电子气的研究工作也已着手进行。半导体表面和界面，电子态和离子注入，激光退火等方面的工作也都得到了加强。理论工作引起了更大的重视，实验工作中较多地建立和使用了较现代化的测试分析仪器。在此基础上取得了一批研究成果，其中既有比较前沿、系统的理论工作，也有与我国半导体和集成技术相适应的应用理论研究。

会议认为，目前我国在半导体物理的各个领域内都不同程度地开展了工作，从布局上看比较合理了，现代化实验方法和设备逐步建立起来了，这些方面与国外的差距在逐渐减小，有些领域也开展了较深入的工作，但总的说来，我们的工作水平还不够高，深度还不够深，这是与国外的主要差距，今后应在进一步改善条件的基础上大力提高我们的研究工作水平，希望能出现更多具有独创性的有意义的论文。

大会建议第五届全国半导体物理学术会议由厦门大学负责筹备于1985年在厦门召开。

(鲍希茂)

Fourth National Conference on Physics of Semiconductors

Nanjing, Jiangsu, China, Nov. 27—30, 1983